PLANNING SALLE BLANCHE 2ème SEMESTRE 2015-2016																	
màj 25/01/2016																	
JANVIER 2016					FEVRIER 2016						MARS 2016						
		TE	FORMATION	TP SEANCE	Gr	_	DA		FORMATION	TP SEANCE	Gr	_	DAT		FORMATION	TP SEANCE	Gr
1	٧	N AN				1	L	M AM	STRBG STRBG	MOSTEC S1/4 MOSTEC S2/4	5+6 5+6	1	М	M AM	PHELMA SEI PHELMA SEI	CAPA-DIODE S1/2 CAPA-DIODE S2/2	5+6 5+6
2	S	Al	VI			2	М	M	STRBG	MOSTEC S2/4	5+6	2	М	AIVI	PHELIVIA SEI PHELMA NANOTECH	MEMS S1/4	3+4
_			_			_		AM	STRBG	MOSTEC S4/4	5+6	_	141		PHELMA NANOTECH	MEMS S2/4	3+4
3	D	N	1			3	М	М				3	J	М	high tech U		
		Αſ	N					AM						AM	high tech U		
4	L	N		MJBB3 + µscope		4	J	M	PHELMA APPRENT.	MOSTEC S3/4	3 et 4	4	V	M	PHELMA BIOMED		5+6
5	М	AN N		MJB3 + µscope		5	W	AM M	PHELMA APPRENT. nano@school	MOSTEC S4/4	3 et 4	5	S	AM M	PHELMA BIOMED	CAPA-DIODE S2/2	5+6
3	IVI	ΑN		MJB3 + µscope		3	ď	AM	nano@school			3	3	AM			
6	М	N				6	s	М				6	D	М			
ľ		Αſ				Ť	1	AM				Ť	Ē	AM			
7	J	N				7	D	М				7	L	М			
		A۱						AM						AM			
8	٧	N		CHAPRON S1/4	gp 6	8	L	М				8	М	М	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S1/2	7+8
		A١	M. Nanobiotech	CHAPRON S2/4 MJB3 + µcroscope	gp 6			AM			l			AM	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S2/2	7+8
9	S	N		мара + дегозсоре		9	М	М	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S1/2	1+2	9	М	М	PHELMA NANOTECH	MEMS S3/4	3+4
Ť	Ť	A۱				Ė	1	AM	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S2/2	1+2	Ė		AM	PHELMA NANOTECH	MEMS S4/4	3+4
10	D	N				10	М	М	PHELMA NANOTECH	MEMS S1/4	1+2	10	J	M	IUT MEPHY MCPC	CAPA S1/2	1+2
		A١						AM	PHELMA NANOTECH	MEMS S2/4	1+2			AM	IUT MEPHY MCPC	CAPA S2/2	1+2
11	L	N		MOSTEC S1/4 MOSTEC S2/4	1+2	11	J	M AM	nano@school			11	V	M AM	PHELMA BIOMED PHELMA BIOMED		7+8
12	М	AN N		MOSTEC S2/4 MOSTEC S3/4	1+2	12	V	M	nano@school PHELMA BIOMED	CAPA-DIODE S1/2	1+2	12	S	M	PRELIMA BIOMED	CAPA-DIODE 52/2	7+8
12	IVI	ΑN		MOSTEC S4/4	1+2	12	ď	AM		CAPA-DIODE S2/2	1+2	12	3	AM			
13	М	N		MOSTEC S1/4	3+4	13	S	M	TTIEEMITOIMES	0/11 / (DIODE 02)E	112	13	D	M			
		A١		MOSTEC S2/4	3+4			AM						AM			
14	J	N		MOSTEC S3/4	3+4	14	D	M				14	L	M			
		A١		MOSTEC S4/4	3+4			AM						AM	B. 151 144 051	0.484 81085 0.46	
15	٧	N AN		CHAPRON S3/4 CHAPRON S4/4	gp 6 gp 6	15	L	M AM				15	М	M AM	PHELMA SEI PHELMA SEI	CAPA-DIODE S1/2 CAPA-DIODE S2/2	9+10 9+10
16	S	N		CHAPICON 34/4	gp 0	16	М	M	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S1/2	3+4	16	М	M	PHELMA NANOTECH	MEMS S1/4	5+6
	Ť	A۱				<u></u>		AM	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S2/2	3+4			AM	PHELMA NANOTECH	MEMS S2/4	5+6
17	D	N				17	М	M	PHELMA NANOTECH	MEMS S3/4	1+2	17	J	M	IUT MEPHY MCPC	CAPA S1/2	3+4
		Αſ						AM	PHELMA NANOTECH	MEMS S4/4	1+2			AM	IUT MEPHY MCPC	CAPA S2/2	3+4
18	L	N AN		MOSTEC S1/4 MOSTEC S2/4	1+2	18	J	M AM				18	٧	M AM	PHELMA FAME PHELMA FAME	CAPA-DIODE S1/2 CAPA-DIODE S2/2	1+2 1+2
19	М	N		MOSTEC S2/4 MOSTEC S3/4	1+2	H	V	M	PHELMA BIOMED	CAPA-DIODE S1/2	3+4	19	S	M	PRELIVIA FAIVIE	CAPA-DIODE 52/2	1+2
10	101	ΑN		MOSTEC S4/4	1+2	19	ľ	AM		CAPA-DIODE S2/2	3+4	13		AM			
20	М	N				20	S	М				20	D	M			
		A١		MOSTEC S2/4	3+4			AM						AM			
21	J	N		MOSTEC S3/4	3+4	21	D	M				21	L	M	Lpro IUT Chimie	biopuce S1	1 gp
22	V	AN N		MOSTEC S4/4	3+4			AM M				22	М	AM M	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S1/2	11+12
1	ľ	ΑN				22	Ė	AM				22	IVI	AM	PHELMA SEI	CAPA-DIODE S2/2	11+12
23	S	N				22	М	M				23	М	M	PHELMA NANOTECH	MEMS S3/4	5+6
		A۱				23		AM						AM	PHELMA NANOTECH	MEMS S4/4	5+6
24	D	N				24	М	M				24	J	M	Lpro IUT Chimie	CAPA S1/2	1 gp
25	ļ.	AN		MOSTEC COM	2 64 4			AM M				25	V	AM	Lpro IUT Chimie PHELMA FAME	CAPA S2/2 CAPA-DIODE S1/2	1 gp
25	L	AN AN		MOSTEC S3/4 MOSTEC S4/4	3 et 4	25	1	AM				25	V	M AM	PHELMA FAME	CAPA-DIODE S1/2	3+4 3+4
26	М	N		MOSTEC S1/4	1+2	00	٧	M				26	S	M	/LLIVI/ T / TIVIL	5 A DIODE 02/2	314
		A١	M PHELMA APPRENT.	MOSTEC S2/4	1+2	26		AM						AM			
27	M	N		MOSTEC S3/4	1+2	27	S	M				27	D	М			
		Αſ		MOSTEC S4/4	1+2	00		AM				00		AM	L . F L Dî		
28	J	AN AN		MOSTEC S1/4 MOSTEC S2/4	3 et 4	28	D	AM				28	L	AM	lundi de Pâques		
20	V	N		WIOSTEC 32/4	3 et 4			M	FC ALT YOULA			29	M	M	PHELMA SIM	CAPA-DIODE S1/2	1+2
1	ľ	A۱				29		AM	FC ALT YOULA			23		AM	PHELMA SIM	CAPA-DIODE S2/2	1+2
30	S	N					Г					30	М	М	PHELMA NANOTECH	MEMS S1/4	7+8
		A۱				L								AM	PHELMA NANOTECH	MEMS S2/4	7+8
31	D	N AN				1						31	J	M	IUT MEPHY MCPC	CAPA S1/2	5+6
		Αľ	VI [<u> </u>								AM	IUT MEPHY MCPC	CAPA S2/2	5+6

		lég	ende								
salle	salle blanche séances					uipemei	nts	utilisés			
3											
	équipements utilisés	chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellipso	profilo	
MOSTEC S1/4	nettoyage +dryox										
MOSTEC S2/4	photolithographie Six + RIE										
MOSTEC S3/4	implant+nett+recuit			,,,,,,,,,,,						,,,,,,,,,,,,,,,,	
MOSTEC S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al		,		-						
MEMO 04/4	équipements utilisés	chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellipso	profilo	
MEMS S1/4 MEMS S2/4	photolithogravure Si poly dopage / implantation + recuit										
MEMS S3/4	alu+SOI-PR+BOE FAR+ litho+etch				_					1	
MEMS S4/4	back side alignment + DRIE					 			 		
IVILIVIO 34/4	équipements utilisés	chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellinso	profilo	
CAPA-DIODE S1/2	nett+dryox+dopage+litho+gravure		WWWWW		IXIL	Tour recurr		rear acpage and r	WIIIIIIIII	promo	
	dépôt + photolitho +gravure alu										
CAN AL DIODE CELE	équipements utilisés	chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellinso	profilo	
MOSTEC S1/5	nettoyage +dryox										
MOSTEC S2/5	photolithographie Six + RIE										
MOSTEC S3/5	dopage / implant+nett+recuit										
MOSTEC S4/5	dépôt LTO et ouverture contacts										
MOSTEC S5/5	dépôt + photolitho +gravure Al										
	équipements utilisés	chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellipso	profilo	
biopuce S1	LithoOX+etchKOH+nett+wetox										
biopuce S2	hydroxylation										
	équipements utilisés	chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P		profilo	
CAPA S1/2	nett + DRYox										
CAPA S2/2	dépôt + photolitho +gravure alu										
	équipements utilisés		four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellipso	profilo	
high tech U S1/2	LITHO avec 2*2 groupes 1h + 1 gp IMEP										
high tech U S2/2	LITHO avec 2*2 groupes 1h + 1 gp IMEP										
D) / O4 /4	équipements utilisés	chimie	four ox	litho	RIE	four recuit	PVD	four dopage diff P	ellipso	profilo	
PV S1/4	litho+gravure ox+textu+diff'Ph										
PV S2/4	désox, nettoyage, dépôt Al				-	 			1	-	
PV S3/4	RTA, dépôt SiN, photolitho				_	 			!	-	
PV S4/4	BOE, dépôt alu, lift off équipements utilisés		£		RIE	fa	PVD	face danger diff D	-11:		
CHAPRON S1/4	equipements utilises ouvertures ZA + implantation	CHITTIE	TOUT OX	litho	KIE	four recuit	LVD	four dopage diff P	ellipso	profilo	
CHAPRON S2/4	photolitho+gray. Ox. +dryOx TTh				_		-		-		
CHAPRON S3/4	ouverture des contacts										
CHAPRON S4/4	dépôt + photolitho +gravure Al										

fête de la science HTU - découverte ING

we et jour férié

pont à confirmer formation continue FC prgm européens

FI libre travaux/contrôles